

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
高周波増幅および中速度スイッチング用
工業用

NPN Silicon Epitaxial Transistor
High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching
Industrial Use

○2SA1154とコンプリメンタリで使用できます。

○小形で P_T が大きく、高耐圧である。

$P_T=1\text{ W}$, $V_{CE0}=60\text{ V}$

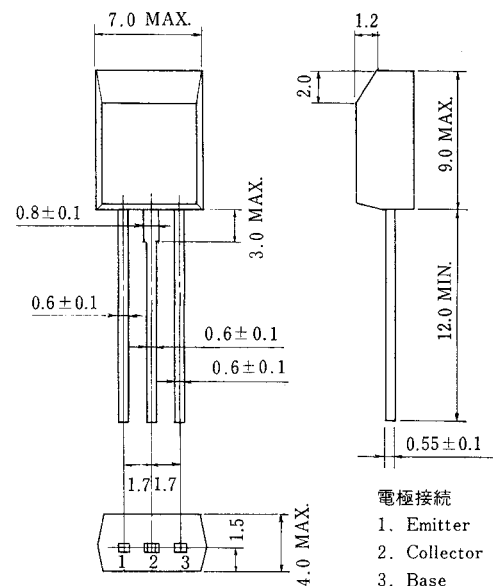
絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	0.7	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(pulse)}$ *	1.0	A
全損失	P_T	1	W
ジャンクション温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

*PW≤10ms, duty cycle≤50%

外形図／PACKAGE DIMENSIONS

(Unit: mm)



電極接続
1. Emitter
2. Collector
3. Base

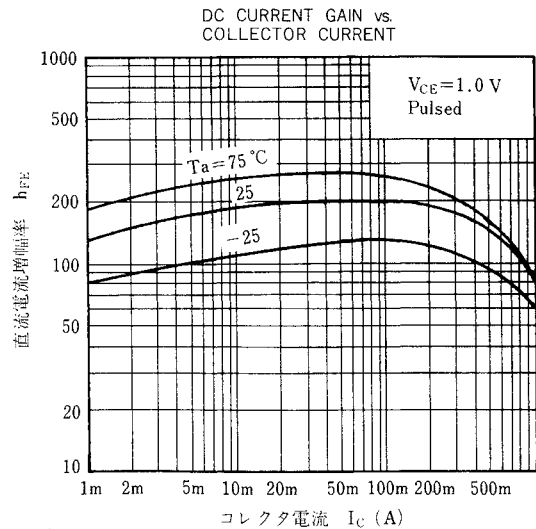
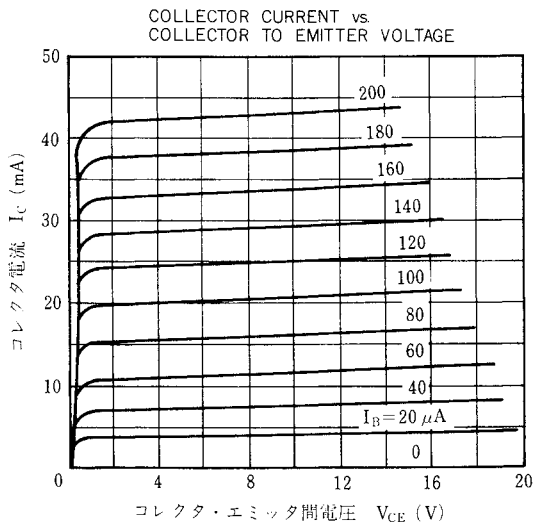
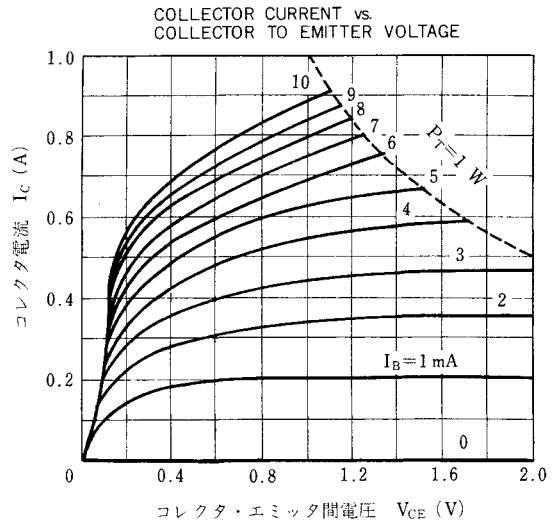
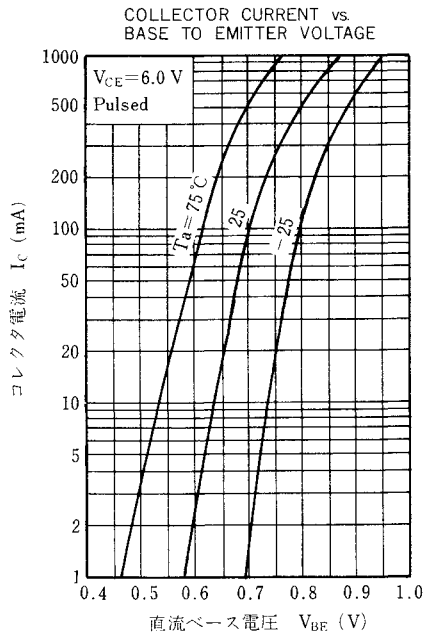
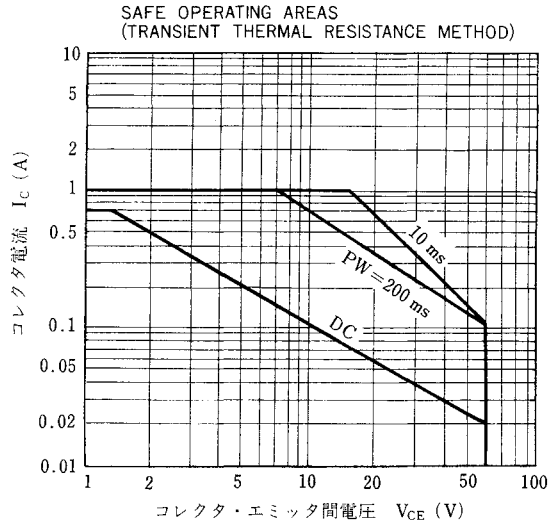
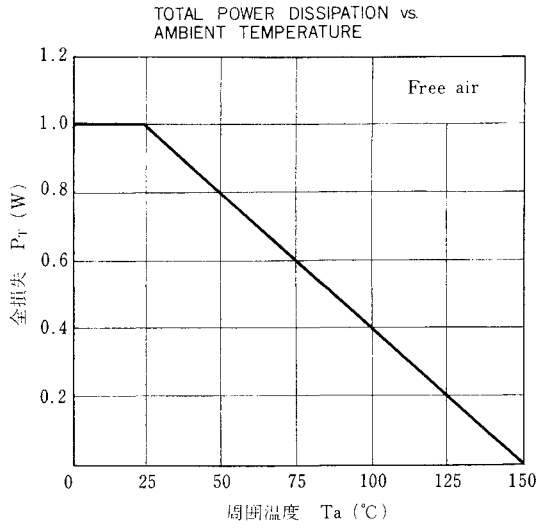
電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=60\text{ V}$, $I_E=0$			100	nA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{ V}$, $I_C=0$			100	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=1.0\text{ V}$, $I_C=0.1\text{ A}$ *	90	200	400	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=1.0\text{ V}$, $I_C=0.5\text{ A}$ *	50	150		
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE}=6.0\text{ V}$, $I_C=10\text{ mA}$	600	635	700	mV
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.5\text{ A}$, $I_B=50\text{ mA}$ *		0.12	0.35	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=0.5\text{ A}$, $I_B=50\text{ mA}$ *		0.90	1.2	V
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=6.0\text{ V}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{ MHz}$		13		pF
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=6.0\text{ V}$, $I_E=-10\text{ mA}$		110		MHz
ターンオン時間	t_{on}	測定回路図参照／See test circuit		60		ns
蓄積時間	t_{stg}			600		ns
ターンオフ時間	t_{off}			650		ns

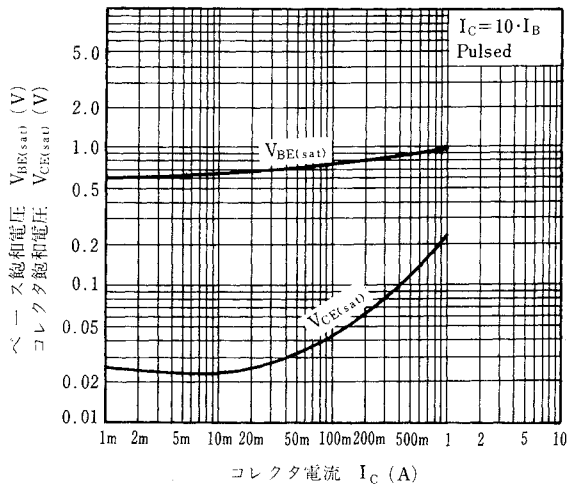
*パルス測定 PW≤350 μs, duty cycle≤2%/Pulsed

h_{FE1} 区分/ h_{FE1} Classification MA: 90~180 LA: 135~270 KA: 200~400

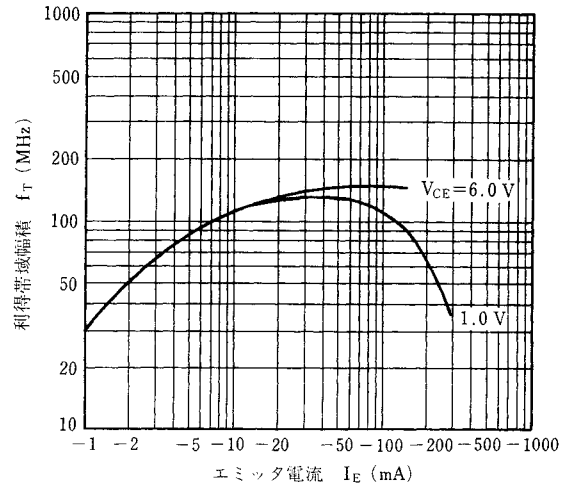
特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)



BASE AND COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. COLLECTOR CURRENT



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE

